

Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором обогащением, n-канала и встроенным обратносмещенным диодом. Предназначены для использования в источниках вторичного электропитания с бестрансформаторным входом, в регуляторах, стабилизаторах с непрерывным импульсным управлением, блоках питания ЭВМ, схемах управления электродвигателей и другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемый для народного хозяйства

Особенности

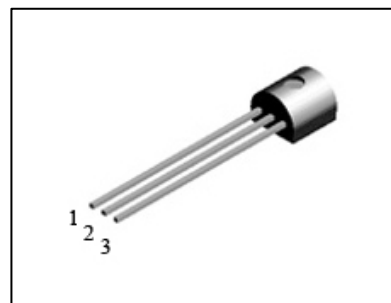
- аналог BSS88

Обозначение технических условий

- АДБК.432140.690 ТУ

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)



Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Затвор
№2	Сток
№3	Исток

Таблица 1. Основные электрические параметры КП504

Параметры	Обознач.	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Остаточный ток стока	I _{c ост}	мкА	U _{си} =U _{си max} , U _{зи} =0		1,0
Пороговое напряжение	U _{зи пор}	В	I _c =1.0мА, U _{зи} =U _{си}	0,6	1,2
Ток утечки затвора	I _{з ут}	нА	U _{си} =0, U _{зи} = ±20В	-	100
Постоянное прямое напряжение диода КП504А, В, Г, Д КП504Б, Е	U _{пр}	В	U _{зи} =0, I _c =-0,5А t _и <300мкс. Q=50		1,3 1,8
Крутизна характеристики	S	А/В	U _{си} =5,0В, I _c =0,25А t _и <300мкс. Q =50	0,14	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии КП504А,Б,В, Д, Е	R _{си отк}	Ом	I _c =0,25А, U _{зи} =4.5В I _c =14мА, U _{зи} =1.8В t _и <300мкс. Q >50		8 15
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии КП504Г	R _{си отк}	Ом	I _c =250мА, U _{зи} =4.5В I _c =14мА, U _{зи} =1.8В t _и <300мкс. Q >50		10 18
Время включения	* t _{вкл}	нс	U _{зи} =10В, I _c = 0,28А U _{си} =30В, R _{зи} =50 Ом t _и <300мкс. Q >50		23
Время выключения	* t _{выкл}	нс	U _{зи} =10В, I _c = 0,28А U _{си} =30В, R _{зи} =50 Ом t _и <300мкс. Q >50		95
Входная емкость	* C _{1и}	пФ	U _{зи} =0, U _{си} =25В, f=1МГц		140
Выходная емкость	* C _{2и}	пФ	U _{зи} =0, U _{си} =25В, f=1МГц		30
Проходная емкость	* C _{12и}	пФ	U _{зи} =0, U _{си} =25В, f=1МГц		9

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КП504

Параметры	Обозначение	Ед. изм	Значение
Напряжение сток-исток КП504А, Б, Д, Е КП504В КП504Г	U _{си max}	В	240 200 250
Напряжение затвор-исток	U _{зи max}	В	±10
Постоянный ток стока КП504А, Б КП504В, Д, Е КП504Г	I _{c max}	мА	250 200 180
Импульсный ток стока	I _{c и max}	А	1,0
Рассеиваемая мощность КП504А, Б КП504В, Г, Д, Е	P _{max}	Вт	1,0 0,7
Температура перехода	T _{пер}	°С	150



Система менеджмента качества проектирования, разработки и производства дискретных полупроводниковых приборов и интегральных микросхем соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001

ОАО «ИНТЕГРАЛ» филиал «Транзистор»
220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16

управление маркетинга: тел. + 375 17 212 59 32
отдел главного конструктора: тел. + 375 17 278 41 01
конструкторско-технологический отдел: тел. + 375 17 278 05 14

<http://www.transistor.by>